

9016M (3DG9016M)

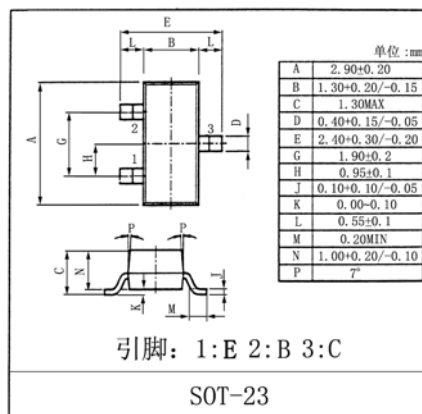
硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于 AM 变频及 FM 的低噪声高频放大。/Purpose: AM converter, FM low noise high frequency amplifier.

特点: P_c 大。/Features: High P_c .

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	30	V
V_{CE0}	20	V
V_{EB0}	4.0	V
I_C	25	mA
I_B	5.0	mA
P_c	310	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=0.1\text{mA}$ $I_E=0$	30			V
V_{CE0}	$I_C=1.0\text{mA}$ $I_B=0$	20			V
I_{CB0}	$V_{CB}=30\text{V}$ $I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=3.0\text{V}$ $I_C=0$			0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$	28		198	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=1.0\text{mA}$		0.1	0.3	V
V_{BE}	$V_{CE}=5.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$		0.72		V
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$	400	620		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		1.2	1.6	pF
NF	$V_{CE}=5.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$ $R_g=50\Omega$ $f=100\text{MHz}$		3.0	5.0	dB

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	D	E	F	G	H	I
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	28~45	39~60	54~80	72~108	97~146	132~198
印章/Marking	HY6D	HY6E	HY6F	HY6G	HY6H	HY6I